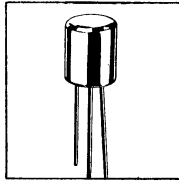


# 2SK25

シリコンNチャネル接合型FET  
FM RF増幅, 混合用



☆FM RF アンプ, 混合用に最適の高周波用 FET です。

- ★Silicon N-channel junction type FET.
- ★For FM RF amplifier and mixer.

## 絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings/ $T_a=25^\circ\text{C}$

項 目	記 号	2SK25	単 位
ドレイン・ソース間電圧	$V_{DSS}$	18	V
ドレイン・ゲート間電圧	$V_{GDS}$	-18	V
ゲート・ソース間電圧	$V_{GSO}$	-18	V
ゲート電流	$I_G$	10	mA
許容損失	$P_D$	100	mW
接合部温度	$T_j$	125	$^\circ\text{C}$
保存温度	$T_{stg}$	-40~+125	$^\circ\text{C}$

## 電気的特性 Electrical Characteristics/ $T_a=25^\circ\text{C}$

項 目	記 号	条 件	min.	typ.	max.	単 位
ゲート・ドレイン間電圧	$BV_{GDS}$	$I_G = -10\mu\text{A}$	-18			V
ゲート遮断電流	$I_{GSS}$	$V_{GD} = -10\text{V}, V_{DS} = 0\text{V}$			-100	nA
ドレイン電流	$I_{DSS} \text{ ※}$	$V_{DS} = 10\text{V}, V_{GS} = 0$	0.6		24	mA
カットオフ電圧	$V_{GS(off)}$	$V_{DS} = 10\text{V}, I_D = 10\mu\text{A}$			-7.2	V
小信号順方向伝達アドミタンス	$ y_{fe} $	$V_{DS} = 10\text{V}, V_{GS} = 0\text{V}, 1\text{kHz}$		6		$\text{m}\Omega$
電力利得	$G_{PS}$	$V_{DS} = 10\text{V}, I_D = 3\text{mA}, 100\text{MHz}$		21		dB
雑音指数	NF	$V_{DS} = 10\text{V}, I_D = 3\text{mA}, 100\text{MHz}$		2.5		dB
帰還容量	$-C_{rs}$	$V_{DS} = 10\text{V}, V_{GS} = 0\text{V}, 1\text{MHz}$		1.1		pF
入力アドミタンス	$\text{Re}(y_{is})$	$V_{DS} = 10\text{V}, I_D = 3\text{mA}, 100\text{MHz}$		0.06		$\text{m}\Omega$
"	$\text{Im}(y_{is})$	"		1.6		$\text{m}\Omega$
出力アドミタンス	$\text{Re}(y_{os})$	"		0.06		$\text{m}\Omega$
"	$\text{Im}(y_{os})$	"		0.65		$\text{m}\Omega$

※ 2SK25 は 10V  $I_{DSS}$  により次のように分類しています。(単位 mA)

0.6	C	1.5	1.2	D	3.0	2.5	E	6.0	5.0	F	12.0	10.0	G	24.0
-----	---	-----	-----	---	-----	-----	---	-----	-----	---	------	------	---	------

- 低周波用 FET は 2SK24 ◯ P 369
- アメリカバンド FM チューナ ◯ P 579, P 580
- 日本バンド FM チューナ ◯ P 581
- AM 3 バンドラジオ ◯ P 589

